

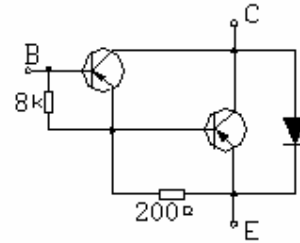
TIPP117

硅 PNP 外延平面达林顿晶体管芯片

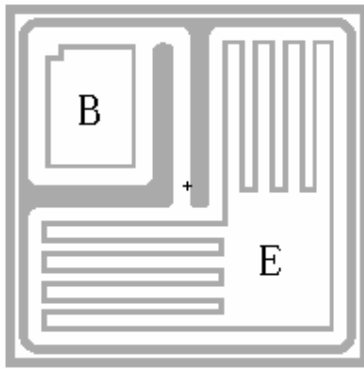
■ 用途:

- * 负电源调整管
- * 音频功率放大器
- * 其他电子电路

■ 内部结构:



■ 芯片示意图



■ 几何结构:

芯片尺寸	1500 μ m × 1500 μ m
压焊区尺寸	基极 324 μ m × 464 μ m 发射极 404 μ m × 544 μ m
锯片槽宽度	80 μ m
芯片厚度	240 ± 10 μ m
金属层	正面 Al 3.1 ± 0.4 μ m 背面 Ag 1.4 ± 0.2 μ m

■ 电特性 (T_a=25℃)

参数名称	符号	测试条件	典型值	最小值	最大值	单位
集电极-基极击穿电压	BV _{CBO}	I _C =-0.1 mA, I _E =0	-160	-100		V
集电极-发射极击穿电压	BV _{CEO}	I _C =-10 mA, I _B =0	-145	-100		V
集电极-发射极维持电压	V _{CEO (sus)} *	I _C =-20mA, I _B =0		-100		V
发射极-基极击穿电压	BV _{EBO}	I _B =-1mA, I _C =0		-4		V
集电极-基极截止电流	I _{CBO}	V _{CB} =-100V, I _E =0			-1	μ A
集电极-发射极截止电流	I _{CEO}	V _{CE} =-100V, I _B =0			-1	μ A
发射极-基极截止电流	I _{EBO}	V _{EB} =-10V, I _C =0	-1.3		-2.5	mA
直流电流增益	h _{FE2}	V _{CE} =-3V, I _C =-1A	4000	2000	15000	
集电极-发射极饱和电压	V _{CES}	I _C =-2A, I _B =-20mA	-1.3		-1.8	V

* V_{CEO (sus)}: 脉宽≤300 μ s, 占空比≤2% (TO—220)